

بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر جابه جایی خارج از صفحه میکروتیر پیزوالکتریکی با سطح مقطع T شکل

على عطار'، محمد طهماسبي يور''* و محمد دهقان

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران ^۲ استادیار، سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران ^۳ دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران مقاله مستقل، تاریخ دریافت ۱/۱۵/۱/۱۹۱، تاریخ بازنگری: ۲۲/۲۹۷/۰ ; تاریخ پذیرش: ۱/۱۹/۱/۱۰

چکیدہ

دستیابی به جابهجایی خارج از صفحه بالاتر در میکروتیرها موجب افزایش حساسیت و دقت میکرو سنسورها و افزایش دامنه جابهجایی و کارآیی میکرومحرکهای مبتنی بر این میکروتیرها میشود. در این مقاله، جابهجایی خارج از صفحه یک میکروتیر پیزوالکتریک با سطح مقطع T شکل به روش المان محدود مدلسازی شده است بهمنظور افزایش جابهجایی خارج از صفحه این میکروتیر، تاثیر پارامترهای هندسی بر جابهجایی خارج از صفحه میکروتیر مذکور به روش تاگوچی بررسی شده است. سطح بهینه متغیرهای هندسی میکروتیر, برای دستیابی به بیشترین جابهجایی خارج از صفحه میکروتیر مذکور به روش تاگوچی بررسی شده است. سطح بهینه متغیرهای هندسی میکروتیر, برای جابهجایی خارج از صفحه با تحلیل واریانس تعیین شده است. در بین مشخصات هندسی تحلیل شده، طول میکرو کانتیلور (L) بیشترین تاثیر را روی میزان جابهجایی خارج از صفحه دارد. با افزایش طول میکرو کانتیلور، جابهجایی خارج از صفحه آن بیشتر می شود. پس از طول، عمق جان تیر (h)، بیشترین تاثیر را بر جابهجایی نوک میکرو کانتیلور، جابهجایی خارج از صفحه آن بیشتر می شود. پس از جایی میکرو کانتیلور بیشتر است. با استفاده از سطوح بهینه متغیرهای هندسی، مقدار جابهجایی خارج از صفحه آن بیشتر می شود. پس از جایی میکرو کانتیلور بیشتر است. با استفاده از سامی میکرو کانتیلور، جابهجایی خارج از صفحه آن بیشتر می شود. پس از مول، عمق جان تیر (h)، بیشترین تاثیر را بر جابهجایی نوک میکرو کانتیلور دارد. هر چه اندازه عمق جان تیر کمتر باشد، میزان جابه-این میکرو کانتیلور بیشتر است. با استفاده از سطوح بهینه متغیرهای هندسی، مقدار جابهجایی خارج از صفحه آن بیشتر می شود. ست آمد که حدود ۲/۲ برابر نتیجه آخرین تحقیق انجام شده در این زمینه است.

کلمات کلیدی: میکروتیر؛ پیزوالکتریک؛ جابهجایی خارج از صفحه؛ تحلیل المان محدود.

Investigation of the Effect of Geometrical Parameters on the Out-of-Plane Displacement of a T-Shaped Piezoelectric Microcantilever

A. Attar¹, M. Tahmasebipour^{2,*}, M. Dehghan³

¹ Master Student, Faculty of New Scienses and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
² Assist. Prof., Faculty of New Scienses and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
³ Master Student, Faculty of New Scienses and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.

Abstract

Achieving to the higher out-of-plane displacement for a piezoelectric microcantilever enhances sensitivity and accuracy of the related microsensors and causes increase in displacement and performance of the related microactuators. In this paper, out-of-plane displacement of a piezoelectric microcantilever with T-Shaped cross section has been modeled using finite element method. With the aim of increase in out-of-plane displacement of the microcantilever with T-Shaped cross section has been modeled using finite element method. With the aim of increase in out-of-plane displacement of the microcantilever, effect of the geometrical parameters on the out-of-plane displacement of the microcantilever has been investigated using the Taguchi method. Optimum levels of the piezoelectric microcantilever geometrical parameters to achieve the maximum out-of-plane displacement were obtained using analysis of the signal to noise ratios and order of the effect importance of geometrical parameters, length of the microcantilever (L) has the most influence on the out-of-plane displacement. Then, beam web depth (h) has the most effect on the out-of-plane displacement of the microcantilever. The less the web depth, the more the out-of-plane displacement of the microcantilever. Using optimum levels of the geometrical parameters, out-of-plane displacement of the microcantilever. Using optimum levels of the result of the latest research conducted in this field.

Keywords: Microcantilever; Piezoelectric; Out-of-Plane Displacement; Finite Element Analysis.

* نویسنده مسئول؛ تلفن: ۲۱-۸۶۹۰۱۸۷ آدرس یست الکترونیک: <u>tahmasebipour@ut.ac.ir</u>

۱– مقدمه

میکرو کانتیلورهای پیزوالکتریک، کاربردهای متنوعی در حوزه تکنولوژی سیستمهای میکروالکترومکانیک دارند. به عنوان مثال، می توان به کاربرد آنها در حسگرهای شیمیایی[1]، بایو حسگرها[۲]، حسگرهای نیرو[۳]، ميكروسوئيچها [۴ و ۵]، ميكروشتاب سنجها [۶ و ۷]، ميكرو آینهها[۸]، سیستمهای موقعیت دهی[۹] و ذخیره سازی انرژی[۱۰–۱۲] اشاره کرد. وجود خاصیت پیزوالکتریک در برخي مواد، باعث تبديل كرنش مكانيكي به انرژي الكتريكي و برعکس می شود. قابلیت مذکور این امکان را ایجاد می کند که در میکرو کانتیلورهای پیزوالکتریک، با اعمال میدان الکتریکی، جابهجایی و نیروی قابل توجهی در نوک میکرو کانتیلورها به وجود آید[۱۳–۱۵]. یکی از مواد دارای خاصیت پیزوالکتریکی قوی، ماده ای است با ترکیب شیمیایی معروف است. این ماده دارای PZT معروف است. این ماده $[Zr_xTi_{1-x}]O_3Pb$ خاصیت ایزوتروپیک عرضی است، به این معنا که در راستای یک محور، خاصیت پیزوالکتریک قویتری در مقایسه با دو محور دیگر دارد. بهعبارتی دیگر، در یک صفحه خاصیت ایزوتروپیک و در جهت عمود بر این صفحه خاصیت اور توتروييک دارد[۱۶].

در سال ۱۹۹۵ مینه و همکاران، موفق به ساخت دو میکروتیر پیزوالکتریک موازی شدند که با اعمال جریان مستقیم (فرکانس پایین) به آنها جابهجایی ۴ میکرومتر و در اولین مد فرکانس تشدید جابهجایی ۳۰ میکرومتر ایجاد کردند[۱۷]. در سال ۱۹۹۶ ایتوه و همکاران، یک میکروتیر از جنس PZT با طول ۲۰۰ میکرومتر ساختند که در فرکانس تشديد ۶۳/۸ كيلوهرتز به ماكزيمم جابهجايي ۱/۵ میکرومتررسید[۱۸]. در سال ۱۹۹۹ کینگ مینگ و اریک کریس، یک میکروتیر از جنس PZT ساخته و به بررسی جابه جایی نوک کانتیلور در ضخامتهای مختلف و در میدانهای الکتریکی متفاوت پرداختند[۱۹]. در سال ۲۰۰۶ شی و همكاران، جابهجایی نوک میکروتیر چند لایه پیزوالکتریک را بررسی کردند. نتیجه به دست آمده، نشان دهنده کاهش جابه جایی با افزایش لایههای کانتیلور بود[۲۰]. در سال ۲۰۰۷ هینون و همکاران، به بررسی جابهجایی نوک کانتیلور پیزوسرامیک PZ29 در ضخامتهای مختلف و در میدانهای الكتريكي متفاوت پرداختند [۲۱]. در سال ۲۰۰۷ پالوساري و

همکاران، به بررسی جابهجایی خطی و نمایی محرک پیزوالکتریک در میدانها و ضخامتهای مختلف پرداختند[۲۲]. ایده ساخت و استفاده از میکروتیر پیزوالکتریکی با سطح مقطع T شکل، توسط متتی و همکارانش در سال ۲۰۱۱ مطرح و در سال ۲۰۱۳ توسعه داده شد[۲۳،۲۴]. مزیت این میکروتیرها امکان ایجاد جابجاییهایی در صفحه و خارج از صفحه با استفاده از یک میکروتیر است. با ساخت این میکرو کانتیلورها، مقدار جابجایی خارج از صفحه ۱۲۹ میکرومتر بدست آمد.

دستیابی به جابهجایی خارج از صفحه بالاتر در میکروتیرها موجب افزایش حساسیت و دقت میکرو سنسورها و افزایش دامنه جابهجایی و کارآیی میکرومحرکهای مبتنی بر این میکروتیرها میشود. تاثیر پارامترهای هندسی میکروتیر پیزوالکتریکی با سطح مقطع T شکل بر جابجایی خارج از صفحه نوک آن، تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مقاله به منظور افزایش جابهجایی خارج از صفحه ایجاد شده در این میکروتیرها، تاثیر پارامترهای هندسی بر جابهجایی خارج از صفحه میکروتیرهای مذکور به روش المان محدود تحلیل شده است. با بکارگیری روش تاگوچی در طراحی آزمایشات مدلسازی، سطوح بهینه پارامترهای هندسی برای دستیابی به جابجایی خارج از صفحه بیشتر و ترتیب اهمیت پارامترهای مذکور با تحلیل واریانس (ANOVA) تعیین شده اند. با استفاده از سطوح بهینه متغیرهای هندسی، مقدار جابهجایی خارج از صفحه ۲۹۶/۳ میکرومتر بدست آمد که حدود ۲/۳ برابر نتیجه آخرین تحقیق انجام شده در این زمینه [۲۳] است.

۲- کلیات مدلسازی

برای تحلیل میکروتیرهای مورد مطالعه از نرم افزار المان محدود کامسول^۲استفاده شده است. شکل ۱ تصویر راستای طولی نمای جانبی میکروتیر با سطح مقطع T شکل و جابه-جایی خارج از صفحه آن را نشان میدهد. پارامترهای هندسی سطح مقطع میکروتیر، در شکل ۲ نشان داده شده است. روی سطح بالایی جان تیر و سطح زیرین فلنج،

¹ Analysis of Variance

² COMSOL

دوالکترود لایه نشانی شده است که الکترودهای مورد نیاز برای اعمال ولتاژ میباشند. مطابق شکل ۱، در اثر اعمال ولتاژ به الکترودهای مذکور، در انتهای آزاد میکروتیر جابهجایی خارج از صفحه ایجاد میشود. جنس میکروتیر مذکور 4-PZT فرض شده است که در راستای ضخامت کانتیلور قطبی است. مشخصات این ماده در جدول ۱ آورده شده است. به علت ناچیز بودن ضخامت الکترودها در مقایسه با ضخامت کانتیلور، در تحلیل المان محدود، تاثیر مکانیکی آنها نادیده گرفته شده است.

مدل تحلیلی جابجایی نوک یک تیر از جنس PZT در مرجع [۱۹] ارائه شده است. این مدل بر اساس تئوری تیر اویلر- برنولی بنا نهاده شده است. برای تعیین معادله دیفرانسیلی حاکم بر رفتار تیر مذکور از اصل کار مجازی استفاده شده است.

جدول ۱- مشخصات PZT-4 [۱۸]

مقدار	خاصيت پيزوالكتريك
-122	d ₃₁ ثابت کرنش پیزوالکتریک (pm/V)
78	E مدول یانگ (GPa)
7600	(kg/m³) چگالی (
0.3176	k ₃₁ ضريب كوپلينگ الكترومكانيكي
1.1510e-0.08	(C^2m^{-2}/N) ضریب گذردهی (ϵ_{33}

۳- طراحی آزمایش های مدل سازی بر مبنای روش تاگوچی

روش تاگوچی ابزاری قوی برای طراحی آزمایشها و طریقی ساده، مؤثر و سیستماتیک برای تعیین سطح بهینه متغیرهای فرآیند است. این روش در مقایسه با روشهای سنتی، تعداد آزمایشهای مورد نیاز برای مدل کردن توابع پاسخ^۱ را به شدت کاهش میدهد. روشهای سنتی طراحی آزمایش، با تغییر یک پارامتر در یک زمان و ثابت نگهداشتن دیگر پارامترها عمل می کنند. بنابراین برای بررسی تأثیر منحصر به فرد هر پارامتر هزینه و زمان زیادی صرف میشود. در این



شکل ۱- فرم شماتیک جابهجایی خارج از صفحه میکروتیر



حالت، روش طراحی آزمایش تاگوچی،^۲ ابزاری قوی برای کاهش تعداد آزمایشها و صرفه جویی در هزینه و زمان است [۲۵]. درنتیجه برای بررسی تأثیر متغیرهای هندسی میکروتیر بر جابجایی خارج از صفحه نوک آن و تعیین شرایط بهینه برای دستیابی به حداکثر جابجایی، از روش تاگوچی استفاده شد. در این روش با استفاده از طرحهای خاصی از آرایههای متعامد⁷و انجام تعداد کمی آزمایش، امکان بررسی تأثیر متغیرهای یک فرآیند و بهینه سازی شرایط آن فراهم شده است. روش تاگوچی دارای گام های زیر است[۲۲–۲۲]:

۱) تعریف توابع اصلی فرآیند و متغیرهای مربوطه

- ۲) تعریف محدوده متغیرها و تعداد سطح آنها
- ۳) انتخاب یک آرایه متعامد مناسب برای تعریف چیدمان متغیرها و سطوح مربوطه و انجام آزمایشها مطابق با آرایه مذکور
- ۴) مطالعه نتایج آزمایشها به روش آنالیز ضرایب S/N^{*} (سیگنال به نویز) برای تعیین سطح بهینه متغیرهای فرآیند

² Taguchi

 ³ Orthogonal Array
⁴ Signal/Nois (S/N) Ratio

 ۵) بررسی ضرایب S/N به روش آنالیز واریانس (ANOVA)⁽ برای تعیین میزان اهمیت تأثیر متغیرها بر تابع مورد مطالعه

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر ۵ متغیر هندسی میکروتیر(L طول، b ضخامت جان تیر، S پهنای فلنچ، t ضخامت فلنج و h عمق جان تیر) بر جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر است؛ بنابراین مقدار جابهجایی خارج از صفحه میکروتیر به عنوان تابع اصلی فرآیند تعریف شده صفحه میکروتیر به عنوان تابع اصلی فرآیند تعریف شده آنها با نتایج آخرین تحقیق انجام شده در این زمینه [۲۳]، هر یک از این ۵ متغیر در ۵ سطح، مطابق جدول ۲، تعریف شدهاند. متغیر غیر کنترلی، ولتاژ اعمالی است که به صورت شدهاند. متغیر غیر کنترلی، ولتاژ اعمالی است که به صورت ثابت و مقدار ۲۰۰ ولت فرض شده است. برای تعریف چیدمان آزمایشها از یک آرایه متعامد ($(5^5)_{22}$ ، مطابق جدول ۳ استفاده شده است.

جدول ۲- متغیرهای هندسی میکروتیر و سطوح تعریف شده

h (μm)	t (µm)	S (μm)	b (μm)	L (µm)	متغير
40	35	140	50	3600	سطح ۱
48.75	38.75	180	62.5	5300	سطح ۲
57.5	42.5	220	75	7000	سطح ۳
66.25	46.25	260	87.5	8700	سطح ۴
75	50	300	100	10400	سطح ۵

هر چه مقدار جابهجایی خارج از صفحه میکروتیر پیزوالکتریک بیشتر باشد، نشان دهنده عملکرد مطلوبتر آن است؛ بنابراین در تحلیل ضرایب سیگنال به نویز حالت بزرگتر بهتر، انتخاب شده است. برای محاسبه ضرایب سیگنال به نویز (S/N)، از رابطه ۱ استفاده می شود[۲۷]:

$$\frac{S}{N} = -10 \log_{10} \left[\frac{(\sum_{i=1}^{n} (\frac{1}{y_{i}^{2}}))}{n} \right]$$
(1)

در رابطه ۰، ۷ پاسخ آزمایش i ام و n تعداد تکرار هر آزمایش است. مقادیر جابهجایی خارج از صفحه میکروتیرهای مدلسازی شده و مقادیر ضرایب سیگنال به نویز مربوطه بر اساس آرایه متعامد L₂₅ محاسبه شده و در جدول ۳ داده شده است.

در گام بعدی با استفاده از مقادیر سیگنال به نویزهای به دست آمده، میانگین نسبت سیگنال به نویز برای هر پارامتر در هر سطح محاسبه میشود. مقدار میانگین ضرایب سیگنال به نویز برای سطوح مختلف متغیرهای فرآیند محاسبه شده است که نتایج آن در جدول ۴ آورده شده است. شکل ۳ نشان دهنده تاثیر سطوح مختلف پارامترهای هندسی مورد مطالعه بر مقدار ضریب سیگنال به نویز است.

بر اساس نتایج جدول ۴ و شکل ۳ مشخص میشود که:

- ۱- افزایش طول کانتیلور L، منجر به افزایش جابهجایی خارج از صفحه میشود؛ بنابراین برای دستیابی به حداکثر جابهجایی خارج از صفحه، سطح پنجم این متغیر بهترین سطح در محدوده مقادیر آزمایش شده است. مطابق با رابطه تحلیلی ارائه شده در مرجع [۲۳]، جابجایی خارج از صفحه میکروتیر با توان دوم طول میکروتیر رابطه مستقیم دارد.
- ۲- افزایش b منجر به کاهش جابهجایی خارج از صفحه می گردد؛ بنابراین سطح اول این متغیر که دارای کمترین مقدار است، سطح بهینه متغیر برای دستیابی به بیشترین مقدار جابهجایی خارج از صفحه است.
- ۳- افزایش S منجر به افزایش جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر میشود؛ در نتیجه جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر در سطح پنجم از این متغیر، بیشترین مقدار است.
- ۴- افزایش t تاثیر قابل توجهی بر جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر ندارد.
- ۵- افزایش h منجر به کاهش جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر می گردد. بنابراین برای دستیابی به حداکثر جابهجایی خارج از صفحه، استفاده از سطح اول این متغیر توصیه می شود.

عطار و همکاران | ۵

نسبت سیگنال به نویز	جابهجایی خارج صفحه		سى	, های هند	متغد		
	(متغیرهای هندسی جابهجایی خارج صفحه				. 1 .7 4 .	
(دسی بل)	(ميكرومتر)	h	t	S	b	L	سماره ازمايس
29.94	31.42	1	1	1	1	1	1
27.28	23.12	2	2	2	2	1	2
24.95	17.68	3	3	3	3	1	3
22.88	13.93	4	4	4	4	1	4
21.02	11.246	5	5	5	5	1	5
30.76	34.52	4	3	2	1	2	6
28.70	27.22	5	4	3	2	2	7
34.02	50.23	1	5	4	3	2	8
34.21	51.36	2	1	5	4	2	9
23.87	15.61	3	2	1	5	2	10
39.03	89.48	2	5	3	1	3	11
37.57	75.62	3	1	4	2	3	12
35.35	58.53	4	2	5	3	3	13
27.09	22.618	5	3	1	4	3	14
37.16	72.12	1	4	2	5	3	15
38.17	80.97	5	2	4	1	4	16
44.79	173.55	1	3	5	2	4	17
39.68	96.39	2	4	1	3	4	18
38.25	81.76	3	5	2	4	4	19
35.78	61.54	4	1	3	5	4	20
44.94	176.55	3	4	5	1	5	21
40.36	104.24	4	5	1	2	5	22
37.59	75.74	5	1	2	3	5	23
47.13	227.16	1	2	3	4	5	24
44.75	172.80	2	3	4	5	5	25

جدول ۳- آرایه متعامد L₂₅



سطوح محلف منعیرها شکل۳- تاثیر سطوح مختلف متغیرهای هندسی میکروتیر بر ضریب S/N

مختلف متغيرها							
	1 1						
h	t	S	b	L	مىغيرھا		
38.61	35.02	32.19	36.57	25.22	سطح ۱		
36.40	34.36	34.21	35.74	30.31	سطح ۲		
33.92	34.48	35.12	34.32	35.24	سطح ۳		
33.03	34.68	35.48	33.92	39.33	سطح ۴		
30.52	34.54	36.07	32.52	42.95	سطح ۵		

جدول ۴- میانگین ضرایب سیگنال به نویز برای سطوح

بر اساس نتایج مذکور، ترکیب بهینه سطوح مختلف فرآیند برای ایجاد بیشترین جابهجایی خارج از صفحه به ترتیب عبارتند از: طول ۱۰/۴ میلیمتر (سطح ۵)، ضخامت جان تیر ۵۰ میکرومتر (سطح ۱)، پهنای فلنج ۳۰۰

میکرومتر (سطح ۵)، ضخامت فلنج ۳۵ میکرومتر (سطح ۱) و عمق جان تیر ۲۵ میکرومتر (سطح ۱) می باشد.

۴- تحلیل واریانس ضرایب سیگنال به نویز

برای تعیین ترتیب اهمیت تاثیر پارامترهای مورد مطالعه بر جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر، از تحلیل واریانس در ضرایب سیگنال به نویز استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس در جدول ۵ آورده شده است. در این جدول f درجه آزادی، ss مجموع مربعات و V واریانس می باشد. هرچه مقدار F (نسبت واریانس متغیر به واریانس خطا) و ($()P_P$ (درصد کل پارامتر بر جابهجایی خارج از صفحه نوک میکروتیر است. پنابراین بر اساس نتایج تحلیل واریانس ضرایب سیگنال به نویز، متغیرهای هندسی میکروتیر به ترتیب اهمیت تاثیر عبارتند از: طول میکروتیر (L)، عمق جان تیر (h)، ضخامت جان تیر (b)، پهنای فلنج (S) و ضخامت فلنج (t). در بین متغیرهای مورد مطالعه L و h بیشترین تاثیر را بر جابهجایی

خارج از صفحه دارند. b و s تاثیر کمتر و تاثیر t تقریبا قابل چشم پوشی است.

۵- آزمایش تصدیق

آخرین مرحله در استفاده از روش تاگوچی، انجام آزمایش تصدیق برای سنجش درستی نتایج حاصل می باشد. در این آزمایش مقادیر متغیرهای هندسی میکروتیر T شکل پیزو از صفحه ایجاد شده در نوک میکروتیر اندازهگیری شد. با انجام این آزمایش مقدار جابهجایی خارج از صفحه برابر انجام این آزمایش مقدار جابهجایی خارج از صفحه برابر متوسط نتایج شبیه سازیهای انجام شده می باشد. ضریب S/N این آزمایش (dB) ۷۷/۷۷ می باشد که در مقایسه با میانگین ضرایب S/N آزمایشات انجام شده، ضریب S/۱۶ برای سطح های بهینه (η_{opt}) با استفاده از رابطه ی زیر قابل بیش بینی است[۷۲]:

$$\eta_{opt} = \eta_m + \sum_{i=1}^{p} (\bar{\eta}_i - \eta_m) \tag{7}$$

در رابطه بالا، η_m میانگین کل ضرایب سیگنال به نویز آزمایشهای انجام شده، p تعداد پارامترهای مورد مطالعه و $\overline{\eta_i}$ میانگین مقدار ضریب سیگنال به نویز در سطح بهینه هر پارامتر می باشد. مقدار پیش بینی شده ضریب سیگنال به نویز برای آزمایش تصدیق و مقدار محاسبه شده با استفاده از نتیجه شبیه سازی به روش المان محدود در جدول ۶ آورده شده است، مشاهده می شود که مطابقت خوبی بین مقدار پیش بینی شده و نتیجه حاصل از آزمایش تصدیق وجود دارد.

۶– اعتبار سنجی مدل

برای ارزیابی اعتبار مدل ارائه شده، جابهجایی خارج از صفحه چهار میکروتیر از جنس PZT-4 با مشخصات مندرج در جدول ۷ مدلسازی شد و مطابق شکل ۴، نتایج حاصل با نتایج تجربی و مدلسازی عددی ارائه شده در مرجع [۲۳] مقایسه شد. مشاهده می شود که مطابقت بسیار خوبی بین نتایج حاصل از مدلسازی به روش المان محدود و نتایج تجربی و مدلسازی عددی وجود دارد که این امر اعتبار

مدلسازی ارائه شده در این مقاله را به اثبات می رساند. از تعداد ۲۵ مدلسازی انجام شده، درصد خطای نتایج ۲۰ مدلسازی نسبت به نتایج آزمایشهای تجربی، کمتر از ۵ درصد و درصد خطای ۵ مدلسازی بین ۵ تا ۲۰ درصد بوده است. برای محاسبه جابهجایی خارج از صفحه میکروتیرها، الکترود پایینی به عنوان زمین در نظر گرفته شد و به الکترود بالایی ولتاژهای ۱۰ تا ۲۰۰ ولت اعمال شد. بنابراین میدان الکتریکی اعمال شده در محدوده ۱/۰ تا ۲ *ساب/* قرار داشت.

جدول ۵- آنالیز واریانس ضرایب سیگنال به نویز

$P_P(\%)$	F	V	SS	f	پارامتر
75.78	73.29	248.83	995.32	4	L
3.84	3.71	12.58	50.33	4	b
3.48	3.37	11.43	45.73	4	S
0.10	0.10	0.33	1.31	4	t
15.77	15.26	51.80	207.19	4	h
1.03	-	3.40	13.58	4	خطا
100	-	-	1313.48	24	کل

جدول ۶- نتایج آزمایش تصدیق					
بهينه	شرايط				
آزمايش	پیش بینی				
1,1,5,1,5	1,1,5,1,5	سطح			
47.13	50.77	نسبت سیگنال به نویز (دسی بل)			

جدول ۷ - پارامترهای ابعادی میکروتیرهای مدل شده

h (µт)	t (μm)	s (μm)	b (µт)	L (mm)	ميكروتير
100	39	139	61	7.7	W1
100	36	208	52	3.8	W2
100	35	149	49	10.4	W3
100	42	144	62	5.8	W4



- [2] Lee JH, et al. (2005) Immunoassay of prostatespecific antigen (PSA) using resonant frequency shift of piezoelectric nanomechanical microcantilever. Biosens Bioelectron 20(10): 2157-2162.
- [3] Lee C, Itoh T, Suga T (1996) Micromachined piezoelectric force sensors based on PZT thin films. IEEE T Ultrason Ferr 43(4): 553-559.
- [4] Mahameed R, et al. (2008) Dual-beam actuation of piezoelectric AlN RF MEMS switches monolithically integrated with AlN contour-mode resonators. J Micromech Microeng 18(10): 105011.

[۵] طهماسبی پور م، سنگ چاپ م، طوفان م (۱۳۹۵) شبیه سازی یک سوئیچ میکروالکترومکانیکی بر پایه کانتیلور پیزوالکتریکی. کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تهران.

[۶] طهماسبی پور م، وفایی ع (۱۳۹۵) مدلسازی شتاب سنج پیزوالکتریکی MEMS به روش المان محدود. بیست و

چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران، شیراز.

- [7] Tahmasebipour M, Vafaei A (2017) A highly sensitive three axis piezoelectric microaccelerometer for high bandwidth applications. Micro Nano 9(2): 111-120.
- [8] Tani M, et al. (2007) A two-axis piezoelectric tilting micromirror with a newly developed PZTmeandering actuator. in Micro Electro Mechanical Systems, MEMS. IEEE 20th International Conference on. 2007. IEEE.

۷- نتیجه گیری

در این تحقیق جابهجایی خارج از صفحه یک میکروتیر پیزوالکتریک با سطح مقطع T شکل به روش المان محدود مدلسازی شد. با استفاده از روش تاگوچی، تاثیر پارامترهای هندسی میکروتیر مورد نظر بر روی جابهجایی خارج از صفحه نوک آن بررسی شد. مشخص شد که سطح بهینه متغیرهای هندسی میکروتیر برای دستیابی به حداکثر جابهجایی خارج از صفحه، در محدوده مدلسازی های انجام شده، عبارتند از: فلنج ۱۰/۴ میلیمتر، ضخامت جان تیر ۵۰ میکرومتر، پهنای فلنج ۲۰۰ میکرومتر، ضخامت فلنج ۳۵ میکرومتر و عمق جان تیر ۵۵ میکرومتر، مخامت فلنج ۳۵ میکرومتر و عمق مانج ۲۰۰ میکرومتر، ضخامت فلنج ۳۵ میکرومتر و عمق موله ۱۰/۴ میلیمتر، مخامت فلنج ۳۵ میکرومتر و عمق مانج ۲۰۰ میکرومتر می باشد. با تحلیل واریانس ضرایب مادی ۲۰۸ میکروتیر نیز بررسی شد. معلوم شد پارامتر هندسی موثر بر جابهجایی خارج از صفحه میکروتیر به ترتیب اهمیت تاثیر عبارتند از: طول تیر، عمق جان تیر، ضخامت ایج

۸- مراجع

 Castille C, Dufour I, Lucat C (2010) Longitudinal vibration mode of piezoelectric thick-film cantilever-based sensors in liquid media. Appl Phys Lett 96(15): 154102.

- [18] Itoh T, Lee C, Suga T (1996) Deflection detection and feedback actuation using a self-excited piezoelectric Pb (Zr, Ti) O3 microcantilever for dynamic scanning force microscopy. Appl Phys Lett 69(14): 2036-2038.
- [19] Wang QM, Cross LE (1999) Tip deflection and blocking force of soft PZT-based cantilever RAINBOW actuators. J Am Ceram Soc 82(1): 103-110.
- [20] Shi Z, Xiang H, Spencer Jr B (2006) Exact analysis of multi-layer piezoelectric/composite cantilevers. Smart Mater Struct 15(5): 1447.
- [21] Heinonen E, Juuti J, Jantunen H (2007) Characteristics of piezoelectric cantilevers embedded in LTCC. J Eur Ceram Soc 27(13): 4135-4138.
- [22] Palosaari J, et al. (2009) Electromechanical performance of structurally graded monolithic piezoelectric actuator. J Electroceram 22(1-3): 156-162.
- [23] Mateti K, et al. (2013) Fabrication and characterization of micromachined piezoelectric Tbeam actuators. J Microelectromech S 22(1): 163-169.
- [24] Kommepalli H, *et al.* (2011) Piezoelectric T-beam actuators. J Mech Design 133(6): 061003.
- [25] Roy RK (2010) A primer on the Taguchi method. Society of Manufacturing Engineers.
- [26] Thomas A, Antony J (2005) A comparative analysis of the Taguchi and Shainin DOE techniques in an aerospace environment. Int J Prod Perform Manag 54(8): 658-678.
- [27] Antony J, Jiju Antony F (2001) Teaching the Taguchi method to industrial engineers. Work Stud 50(4): 141-149.

- [9] Li Y, et al. (2006) Track-following control with active vibration damping of a PZT-actuated suspension dual-stage servo system. J Dyn Syst-T ASME 128(3): 568-576.
- [10] Erturk A, Inman DJ (2009) An experimentally validated bimorph cantilever model for piezoelectric energy harvesting from base excitations. Smart Mater Struct 18(2): 025009.
- [11] طهماسبی پور م، سنگ چاپ م (۱۳۹۵) بهینه سازی یک
- سیستم الکترومکانیکی ذخیره انرژی بر پایه کانتیلور پیزوالکتریکی. کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تهران.

[۱۲] حسینی ر و فاتحی ناراب ه (۱۳۹۶) برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یکسر درگیر با دو لایه پیزوالکتریک. مجله علمی پژوهشی مکانیک سازهها و شارهها ۹–۱ :(۱)۷.

- [13] Furukawa T, Ishida K, Fukada E (1979) Piezoelectric properties in the composite systems of polymers and PZT ceramics. J Appl Phys 50(7): 4904-4912.
- [14] Ajitsaria J, et al. (2007) Modeling and analysis of a bimorph piezoelectric cantilever beam for voltage generation. Smart Mater Struct 16(2): 447.
- [15] Suo Z, et al. (1992) Fracture mechanics for piezoelectric ceramics. J Mech Phys Solids 40(4): 739-765.
- [16] Kogan L, Hui CY, Molkov V (1996) Stress and induction field of a spheroidal inclusion or a penny-shaped crack in a transversely isotropic piezoelectric material. Int J Solids Struct 33(19):2719-2737.
- [17] Minne S, Manalis S, Quate C (1995) Parallel atomic force microscopy using cantilevers with integrated piezoresistive sensors and integrated piezoelectric actuators. Appl Phys Lett 67(26): 3918-3920.